

تأثیر دمای بازپخت بر تحرک پذیری و مشخصه‌های الکتریکی گیت دی الکتریک NiO/PVC

امیر حیاتی

دانشکده فنی و حرفه‌ای امام محمد باقر(ع)، دانشگاه فنی و حرفه‌ای مازندران، ساری

پست الکترونیکی: amhaiaiti@tvu.ac.ir

(دریافت مقاله: ۱۳۹۹/۰۵/۲۴؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳)

چکیده

در ترانزیستورهای اثر میدانی ضخامت گیت دی الکتریک اکسید سیلیکون ۱ تا ۲ نانومتر است. بنابراین کاهش ضخامت گیت به ۱ نانومتر برای تولیدات آتی، سبب افزایش جریان تونلی و نشتی می‌شود. یکی از گزینه‌های مطلوب به عنوان گیت دی الکتریک، نانو کامپوزیت‌های هیبریدی هستند که ثابت دی الکتریک بالا و گاف نواری پهنی داشته و در تماس با زیرلایه یا بستر سیلیکونی تعادل حرارتی دارند. در کار حاضر، نمونه‌های هیبریدی NiO/PVC با غلظت‌های مختلف ماده آلی را به عنوان یک ماده دی الکتریک مناسب به روش سل ژل سنتز کرده و تلاش کردیم به کمک تکنیک تجربی تحلیل حرارتی و مشتق آن، کاهش وزن نمونه‌ها را در مقابل حرارت بررسی کنیم. برای اندازه‌گیری تحرک‌پذیری، ثابت دی الکتریک و رسانندگی نمونه‌های مزبور در دماهای بازپخت مختلف با دستگاه A۱۳۲GPS، از محاسبه انرژی فعال‌سازی در نمودار لگاریتمی رسانندگی برحسب عکس دما استفاده کردیم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که نمونه NiO/PVC:۲ به جهت دارا بودن ثابت دی الکتریک بالاتر جریان نشتی کمتری دارد. رفتار همه نمونه‌ها نسبت به افزایش دما تا دماهای ۴۰۰ کلوین تقریباً یکسان است. تفاوت میان نمونه‌ها در دماهای بالاتر بروز می‌کند، به صورتی که نمونه NiO/PVC:۲ در دماهای بالای ۴۰۰ کلوین تحرک‌پذیری بالاتری دارند.

واژه‌های کلیدی: نانوترانزیستور ماسفت، گیت دی الکتریک، نانو کامپوزیت هیبریدی NiO:PVC، روش سل ژل

۱. مقدمه

آلی-غیرآلی به دلیل دارا بودن مشخصه‌های کیفی مناسب و مطلوب، در کانون توجهات قرار گرفته‌اند.

از این رو از اکسید نیکل به عنوان یک ماده غیر آلی و پلی وینیل کلرید به عنوان ماده آلی با مشخصه‌های کاتالیستی و دی الکتریکی مطلوب استفاده کردیم [۵]. پلی وینیل کلرید به علت ثابت دی الکتریک بالا، سنتز در

درسال‌های اخیر، ضخامت گیت دی الکتریک ترانزیستورهای اثر میدانی حدود یک نانومتر است [۱-۳] بنابراین جریان‌های نشتی، تونلی و نفوذ اتم‌های سبک نظیر بور باعث افت کارایی گیت دی الکتریک می‌شوند [۴]. برای حل این مشکلات نانو کامپوزیت‌های هیبریدی

جدول ۱. ثابت دی الکتریک و سایر پارامترهای مربوط به قرص های نانوکامپوزیتی.

نمونه	ضریب کیفیت	توان اتلافی	ظرفیت بر حسب پیکو فاراد	ثابت دی الکتریک
NiO	۱/۰۰۹	۰/۹۹	۱۷۳/۵	۵۲/۰۴۷
NiO/PVC:۱	۱/۰۱۷	۰/۹۳	۱۸/۱	۵۴/۰۲۱
NiO/PVC:۲	۰/۹۵۰	۱/۰۵	۲۲/۵	۶۸/۰۹۹
NiO/PVC:۳	۱/۰۱۱	۰/۹۸	۱۹/۴	۵۸/۱۰۷

۲۵۰ و ۳۵۰ درجه سانتی گراد مورد بازپخت قرار دادیم. برای ساختن غلظت های ۰/۲ و ۰/۴ گرم از PVC، آزمایش را با همین شرایط تکرار کردیم که به صورت ۱: NiO/PVC، ۲: NiO/PVC و ۳: NiO/PVC مشخص شده اند.

۳. نتایج و بحث

همانطور که در جدول ۱ ملاحظه می کنید ظرفیت، ضریب کیفیت، توان اتلافی و ثابت دی الکتریک قرص های ساخته شده از نمونه ها به ضخامت ۳ میلی متر و قطر ۱/۲ سانتی متر را با دستگاه GPS۱۳۲A و در بسامد یک کیلو هرتز اندازه گرفتیم. مطابق داده های موجود در جدول ۱ نمونه ۲: NiO/PVC ثابت دی الکتریک بزرگ تری دارد.

بیشترین مقدار ضریب کیفیت Q_F بیانگر کمترین آهنگ انرژی از دست رفته نسبت به انرژی ذخیره شده است چون مطابق رابطه (۱)، هر چه ضریب کیفیت بالاتر باشد زمان واهلش کمتر است و از آنجا که ضریب توان اتلافی از معکوس ضریب کیفیت به دست می آید پس با افزایش ضریب اتلافی، انرژی بیشتری تلف می شود.

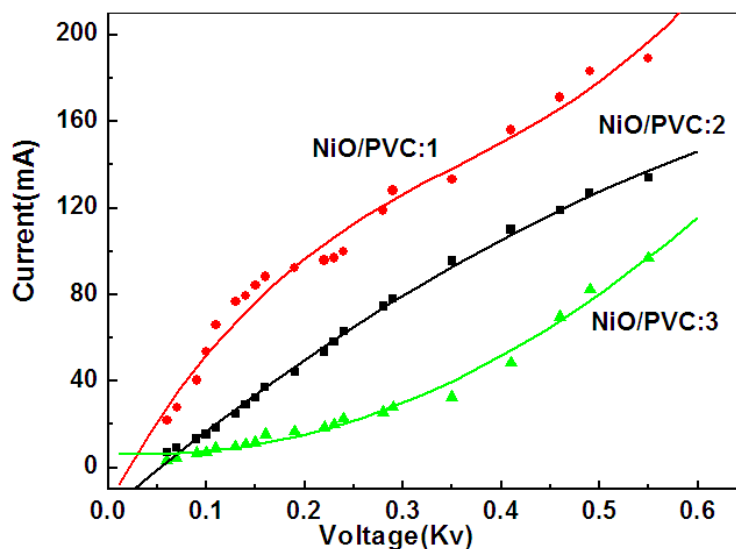
$$Q_F = \left\{ \begin{array}{l} \text{نسبت انرژی ذخیره شده در خازن به} \\ \text{انرژی تلف شده در یک دوره} \end{array} \right\} \times 2\pi, \quad (1)$$

$$Q_F = \frac{1}{D_F}, \quad (2)$$

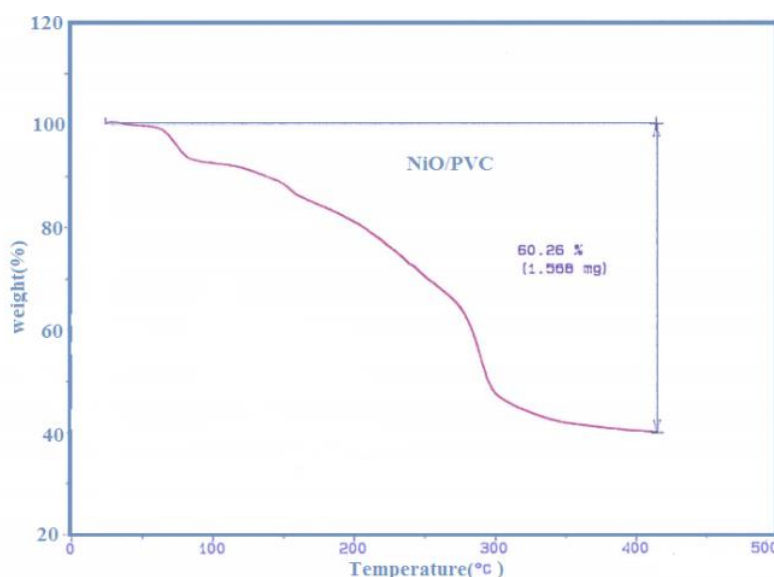
دمای پایین و ارزان بودن برای ما اهمیت دارد. نتایج کار نشان می دهند که نانو کامپوزیت هیبریدی ۲: NiO/PVC در میان سایر نمونه ها از ثابت دی الکتریک بالا، جریان نشستی پایین و تحرک پذیری بالای حامل ها برخوردار است و از این رو برای گیت دی الکتریک نانوترانزیستورهای آتی، نسبت به دی اکسید سیلیسیم ویژگی های الکتریکی مناسب تری را دارند.

۲. تجربی

برای سنتز نانو ذرات NiO/PVC با استفاده از روش سل-ژل از پیش ماده نیترات نیکل ۶ آبه ($\text{Ni(NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)، پلی وینیل کلرید و آب دو بار یونیده به عنوان حلال استفاده کردیم. ابتدا ۵ گرم نیترات نیکل شش آبه را در ۵۰ میلی لیتر آب مقطر حل کرده و برای ۱۵ دقیقه در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد تحت چرخش مغناطیسی قرار دادیم. پس از افزودن ۰/۶ گرم NaOH به محلول و تنظیم pH بین ۷-۱۰ مقدار ۰/۱ گرم PVC را به ۵۰ میلی لیتر آب مقطر افزوده و در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد روی همزن مغناطیسی قرار می دهیم. پس از ده دقیقه، این محلول را به صورت قطره قطره به ظرف اول اضافه کرده و به مدت ۴۸ ساعت روی همزن مغناطیسی در دمای اتاق قرار دادیم. ژل به دست آمده ابتدا به مدت ۲۴ ساعت و در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد در کوره الکتریکی خشک شده و در نهایت پودر حاصل از آن را در دماهای ۱۵۰،



شکل ۱. نمودار I-V مربوط به نمونه های NiO/PVC.



شکل ۲. منحنی TGA مربوط به نانوکامپوزیت هیبریدی NiO/PVC:۲.

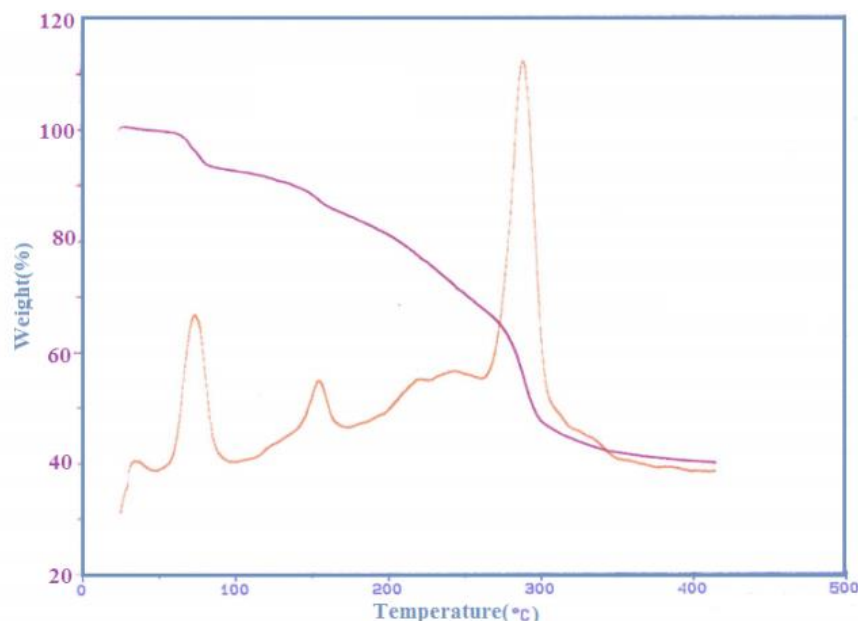
NiO/PVC:۲ به طور تقریبی به صورت یک خط است که رفتار اهمی این نمونه را نشان می دهد. رفتار غیراهمی برای دیگر نمونه ها، به مقاومت ظاهری ارتباط پیدا می کند که می توان آن را به صورت تماس شوتکی لحاظ کرد.

شکل ۲ منحنی TGA نمونه های NiO/PVC را نشان می دهد که کاهش وزن از دمای ۵۰ تا ۳۵۰ درجه سانتی گراد رخ می دهد.

شکل ۱ منحنی های جریان-ولتاژ مربوط به نمونه های NiO/PVC را نشان می دهد که از برازش نقاط به دست آمده از نتایج تجربی به صورت یک معادله درجه شش مطابق رابطه (۳) به دست می آید.

$$I = aV^6 + bV^5 + cV^4 + dV^3 + eV^2 + fV + g, \quad (3)$$

همانطور که ملاحظه می کنید میان جریان و ولتاژ رابطه خطی برقرار نیست و تنها در گستره معینی از ولتاژها رفتار نمونه



شکل ۳. منحنی DTG مربوط به نانوکامپوزیت هیبریدی NiO/PVC:۲.

به این مفهوم است که سازوکار شیمیایی تخریب عوض شده است.

افزایش تحرک پذیری حامل‌ها و کاهش جریان نشتی سبب کاهش ولتاژ آستانه می‌شود که یکی از مشخصه‌های اصلی درانتخاب گیت دی‌الکترونیک است [۶]. برای تعیین خواص الکتریکی نمونه‌ها از فرمول آرنیوس استفاده کردیم که به صورت رابطه (۴) است [۷].

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(\frac{-E_a}{K_B T}\right), \quad (4)$$

σ ضریب رسانندگی، E_a انرژی فعال سازی، σ_0 رسانندگی الکتریکی بیشینه و K_B ثابت بولتزمن است.

مطابق شکل ۴ برای به دست آوردن تحرک پذیری حامل‌ها،

نمودار $\log \sigma$ را برحسب $\frac{1}{T}$ رسم کرده و شیب نمودار را به دست آوردیم که معرف $\frac{E_a}{K_B}$ است و از روی آن می‌توان انرژی فعال سازی و σ_0 را به دست آورد.

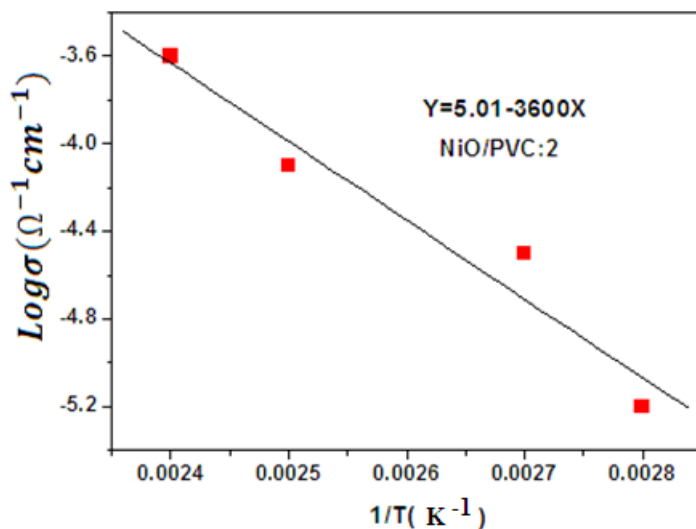
$$\log \sigma = \log \sigma_0 - \frac{E_a}{K_B T}, \quad (5)$$

در ادامه با استفاده از رابطه (۶) به محاسبه تحرک پذیری حامل‌ها پرداختیم که در آن μ تحرک پذیری حامل‌ها و N_0 چگالی

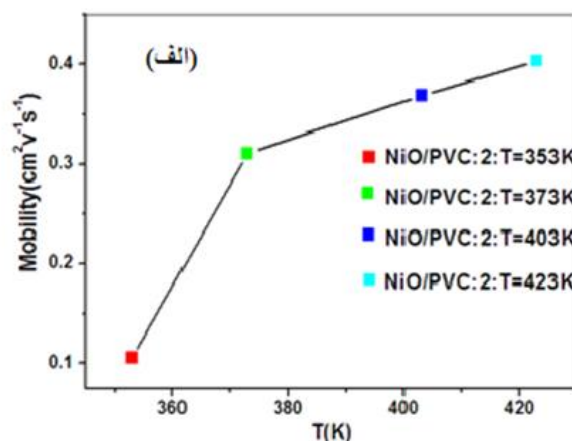
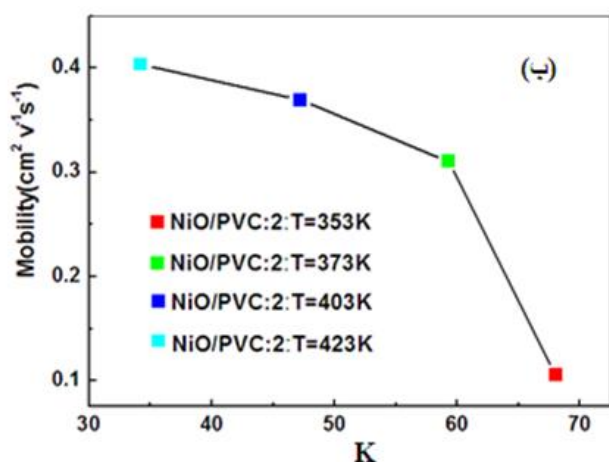
سه تغییر عمده در کاهش وزن از منحنی^۱ مشاهده می‌شود که اولین قله از آهنگ کاهش وزن بین ۵۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد ممکن است مربوط به از دست دادن آب پیش ماده‌ها و تجزیه ناخالصی‌ها و همچنین مواد آلی باشد. قله دوم کاهش وزن بین ۱۳۰ و ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد به تجزیه هیدروکسید نیکل در پیش ماده مربوط است که در آن فاز بلوری NiO از $Ni(OH)_2$ شکل می‌گیرد. سومین قله کاهش وزن بین ۲۹۰ تا ۳۳۰ درجه سانتی‌گراد تجزیه نیترات نیکل در پیش ماده‌ها است. از طرفی در این بازه دمایی، نمونه ۶۰/۲۸ درصد وزن خود را از دست داده و تخریب نمونه تا حدود ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به مقدار رطوبت و حلال‌های باقیمانده در نانوکامپوزیت مربوط می‌شود.

برای اینکه بتوانیم به صورت دقیق سرعت تخریب نمونه را تعیین کنیم از مشتق منحنی TGA تحت عنوان نمودار DTG استفاده کردیم. همانطور که در شکل ۳ می‌بینید بیشترین سرعت تغییرات در منحنی DTG مربوط به نقاطی است که در آن قله مشاهده می‌شود. همچنین هر جا که شیب منحنی وزن ماده برحسب دما عوض شود

۱. Thermogravimetric analysis



شکل ۴. نمودار لگاریتم رسانندگی نمونه NiO/PVC:۲ برحسب عکس دما.



شکل ۵. (الف) نمودار تحرک پذیری نمونه NiO/PVC:۲ برحسب دما و (ب) نمودار تحرک پذیری نمونه NiO/PVC:۲ برحسب ثابت دی الکتریک.

۵. ب ملاحظه می کنید که تحرک پذیری با افزایش ثابت دی الکتریک کاهش یافته است که ممکن است به علت افزایش جایگزیدگی حامل ها به وسیله قطبش الکترونی در دی الکتریک با ثابت دی الکتریک بالا باشد. همچنان که فصل مشترک دی الکتریک-نیم رسانا بیشتر قطبی می شود چگالی حالت های جایگزیده بیشتر می شود. یعنی برهمکنش میان حامل با محیط دی الکتریک به وسیله نزدیک ترین دوقطبی ها غالب می شود. این منجر به برهمکنش پلارون ها با جرم موثر بالا در کانال با

حالت های موثر در ترازهای رسانش بلور است. مقدار تقریبی N_0 برابر 10^{21} در نظر گرفته شده است [۸]. در ادامه نتایج حاصل به همراه تحلیل منحنی ها آمده است.

$$\sigma_0 = eN_0\mu, \quad (6)$$

در شکل ۵. الف می بینیم که با افزایش دما از ۳۵۳ تا ۴۲۳ کلوین، تحرک پذیری حامل ها افزایش یافته است؛ زیرا افزایش دمای بازپخت موجب افزایش چگالی حامل ها در فصل مشترک و در نهایت افزایش تحرک پذیری می شود. همچنین در شکل

۵. نتیجه گیری

برای تعیین خواص الکتریکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های هیبریدی NiO/PVC تلاش کردیم اثر غلظت ماده آلی و دما را بر نتایج بررسی کنیم. نتایج نشان می‌دهد که نمونه‌های NiO/PVC از نظر غلظت تا حدودی رفتاری مشابه دارند، اما نمونه ۲: NiO/PVC در میان سایر نمونه‌ها ثابت دی‌الکتریک بالاتری دارد. بنابراین برای جایگزینی در ترانزیستورهای ماسفت به جای دی اکسید سیلیسیم پیشنهاد می‌شوند.

دوقطبی‌ها می‌شود که باعث کاهش تحرک‌پذیری حامل‌ها می‌شود.

برای محاسبه جریان نشستی، نسبت $\frac{I_{on}}{I_{off}}$ را محاسبه می‌کنیم که در OFET های نوع P از فرمول زیر به دست می‌آید [۹].

$$\frac{I_{on}}{I_{off}} = 1 + \frac{\mu}{\sigma} \frac{CV_d}{rd}, \quad (7)$$

در این فرمول با استفاده از داده‌های جدول ۱ و مقادیر متعارف مربوط به ترانزیستورهای OFET به ازای یک ولتاژ معین $(V_d = -5V)$ نسبت $\frac{I_{on}}{I_{off}} \approx 10^3$ به دست می‌آید که یک نسبت قابل توجه است.

مراجع

1. H Klauk, et al., *J. Appl. Phys.* **92**(2002) 5259.
2. PK Roy and IC Kizilyalli, *Appl. Phys. Lett.* **72**(1998) 2835.
3. M. Shtein, J. Mapel, J.B. Benziger, and S.R. Forrest, *Appl. Phys. Lett.* **81**(2002) 268.
4. Y C Yeo, et al., *Appl. Phys. Lett.* **81**(2002) 2091.
5. A Hayati, and A Bahari, *J Nanostruct*, **4**(2014)
6. PD Ye, et al., *Appl. Phys. Lett.* **86**(2005) 063501.
7. S Nakayama, and M Sakamoto, *J EUR CERAM SOC.* **18**(1998) 1413.
8. TB Singh, et al., *Adv. Mater.* **17**(2005) 2315.
9. S Liu, et al., *Adv. Mater.* **21**(2009) 1217.